

令和3年1月13日

FIoT コンソーシアム

ハイブリッド MEMS デバイス分科会

会長 小林 健

主査 山下 崇博

令和2年度 第2回ハイブリッド MEMS デバイス分科会開催のご案内

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、当コンソーシアムの分科会活動に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。今回はシリコンチップと印刷技術の融合によるハイブリッドデバイスに注目し、12 インチシリコンウエハの接合技術、印刷配線技術によるフレキシブルセンサの製造法、シリコンデバイスの次世代通信技術への応用について弊所の専門家を招いて議論いたしたく、下記要領にて第2回分科会を開催いたします。ご出席のほど、よろしくお願いいたします。

敬具

記

日時：2021年1月22日(金) 15:00~16:55

会場：Microsoft Teams によるオンライン開催

(オンライン会議へのリンクは、参加申込いただいた方に後日ご案内いたします)

予定議題：

15:00~15:05 開会挨拶

ハイブリッド MEMS デバイス分科会 会長 小林 健

15:05~15:30 講演「ウエハレベル3次元積層のための300mmウエハレベルハイブリッド

接合」

産業技術総合研究所デバイス技術研究部門

3D集積システムグループ 主任研究員 藤野 真久

15:30~15:55 講演「スクリーン印刷を用いたフレキシブルセンサ製造技術」

産業技術総合研究所センシングシステム研究センター

ハイブリッドセンシングデバイス研究チーム 主任研究員 山下 崇博

15:55~16:45 講演「5Gのためのフィルタ・振動子の基礎と応用」

産業技術総合研究所 招聘研究員 安藤 陽

16:45~16:50 閉会挨拶・事務連絡等

ハイブリッドMEMS デバイス分科会 主査 山下 崇博

事務局：

国立研究開発法人産業技術総合研究所センシングシステム研究センター内

FIoT コンソーシアム ハイブリッドMEMS デバイス分科会担当

E-mail：M-ssrc-fiot-hymems-ml@aist.go.jp

電話：029-862-6063 (山下)

以上